

(12)特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19)世界知的所有権機関  
国際事務局



(43)国際公開日  
2005年6月16日 (16.06.2005)

PCT

(10)国際公開番号  
WO 2005/055299 A1

- (51)国際特許分類<sup>7</sup>: H01L 21/301, 21/68
- (21)国際出願番号: PCT/JP2004/017955
- (22)国際出願日: 2004年12月2日 (02.12.2004)
- (25)国際出願の言語: 日本語
- (26)国際公開の言語: 日本語
- (30)優先権データ:  
特願2003-403431 2003年12月2日 (02.12.2003) JP  
特願2004-107584 2004年3月31日 (31.03.2004) JP  
特願2004-282807 2004年9月28日 (28.09.2004) JP  
特願2004-282808 2004年9月28日 (28.09.2004) JP
- (71)出願人(米国を除く全ての指定国について): 積水化学工業株式会社 (SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.) [JP/JP]; 〒5308565 大阪府大阪市北区西天満2丁目4番4号 Osaka (JP).
- (72)発明者; および  
(75)発明者/出願人(米国についてのみ): 杉田大平 (SUGITA, Daihei) [JP/JP]; 〒3490198 埼玉県蓮田市黒浜3535 積水化学工業株式会社内 Saitama (JP). 福岡正輝 (FUKUOKA, Masateru) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 畠井宗宏 (HATAI, Munehiro) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 林聰史 (HAYASHI, Satoshi) [JP/JP]; 〒6188589 大阪府三島郡島本町百山2-1 積水化学工業株式会社内 Osaka (JP). 下村和弘 (SHIMOMURA, Kazuhiro) [JP/JP]; 〒3490198 埼玉県蓮田市黒浜3535 積水化学工業株式会社内 Saitama (JP). 北島義一 (KITAJIMA, Yoshikazu)
- (81)指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84)指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ヨーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告書
- 請求の範囲の補正の期限前の公開であり、補正書受領の際には再公開される。

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54)Title: METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR CHIP

(54)発明の名称: 半導体チップの製造方法

(57)Abstract: Disclosed is a method for manufacturing a semiconductor chip which enables to efficiently produce a semiconductor chip without damaging it. The method for manufacturing a semiconductor chip comprises a tape bonding step wherein an adhesive tape for dicing, which has an adhesive layer containing a gas generator that generates a gas when irradiated with light, is bonded to a semiconductor wafer wherein circuits are formed; a dicing step wherein the semiconductor wafer to which the adhesive tape is bonded is diced into separate semiconductor chips; a removing step wherein at least a part of the adhesive tape is removed from each semiconductor chip by irradiating the chip with light; and a pick-up step wherein each semiconductor chip is picked up by a needless pick-up method.

(57)要約: 本発明は、破損させることなく、高い生産効率で半導体チップを得ることができる半導体チップの製造方法を提供することを目的とする。本発明は、回路が形成された半導体ウエハに、光を照射することにより気体を発生する気体発生剤を含有する粘着剤層を有するダイシング用粘着テープを貼付するテープ貼付工程と、前記ダイシング用粘着テープが貼付されたウエハをダイシングして、個々の半導体チップに分割するダイシング工程と、前記分割された個々の半導体チップに光を照射して、半導体チップから前記ダイシング用粘着テープの少なくとも一部を剥離する剥離工程と、前記半導体チップをニードルレスピックアップ法により取り上げるピックアップ工程とを有する半導体チップの製造方法である。

WO 2005/055299 A1